PCT

ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

	Vom Anmeldeamt auszufüllen	
--	----------------------------	--

PCT/EP 00 / 08 2 6 1

Internationales Aktenzeichen

2 4 AUG 2000 Internationales Anmeldedatum

24 08. 2000)

EUROPEAN PATENT OFFICE

PCT INTERNATIONAL APPLICATION
Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) 799129 b. 0. 10

	(max. 12 Zeichen)	799/29 WO. 1P
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG		
siehe Blatt 5		
Feld Nr. II ANMELDER		
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Pers Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name a in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Anmelders, soscrn nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitze.	sonen vollständige am les Staats anzugeben. Sitzes oder Wohnsitze. s angegeben ist.)	liche Der s des Diese Person ist gleichzeitig Erfinder
DEUTSCHE TELEKOM AG Friedrich-Ebert-Allee 140		Telefonnr.:
53113 Bonn DE		Telefaxnr.:
		Fernschreibnr.:
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsit	
DE.	<u> </u>	DE
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungss für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten alle Gestimmungsstaaten alle Gestimmungsstaaten alle Gestimmungsstaaten alle Bestimmungsstaaten alle Gestimmungsstaaten alle Gestimm	taaten mit Ausnahme naten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEIT		
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Pers Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name d in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitze. DULTZ; Wolfgang Marienberger Str. 37	sonen vollständige am. les Staats anzugeben. Sitzes oder Wohnsitze. s angegeben ist.)	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder
65936 Frankfurt/M. DE		nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsit	z (Staat): DE
Diese Personist Anmelder alle Bestimmungsst für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten Sta	aaten mit Ausnahme aten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf ein	em Fortsetzungsblat	t angegeben.
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRE	TER; ZUSTELLA	NSCHRIFT
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um fi vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigen	ür den (die) Anmelde schaft zu handeln al:	Anwalt gemeinsamer Vertreter
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen volls Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name d	tändige amtliche Bezeichm les Staats anzugeben.)	ing. Telefonnr.: 06151/83-58 40
Deutsche Telekom AG		Telefaxnr.:
Rechtsabteilung (Patente) PA1 64307 Darmstadt		06151/83-58 43
Deutschland		Fernschreibnr.:
Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn keim obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist	ein Anwalt oder gem	einsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen

Formblatt PCT/RO/101 (Blatt 1) (Juli 1998; Nachdruck Juli 1999)

Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular



Blatt Nr.2

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND	O/ODER (WEITERE) E	RFINDER	
Wird keines der folgenden Felder benutzt, so		Antrag nicht beigefügt werden.	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personateichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Si Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes GANZKE; Dirk Heidelbergerstr. 63 64285 Darmstadt DE	nen vollständige amtliche s Staats anzugeben. Der tzes oder Wohnsitzes des angegeben ist.)	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)	
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at): DE	
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaten alle Bestimmungsstaten der Vereinigten Staat	aten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Perso Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name de in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Si Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes HAASE; Wolfgang Im Trappengrund 72 64354 Reinheim DE	men vollständige amtliche 25 Staats anzugeben. Der itzes oder Wohnsitzes des angegeben ist.)	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)	
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Sta	nat): DE	
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaten alle Bestimmungsstaten alle Bestimmungsstaten der Vereinigten Stat	aaten mit Ausnahme aten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personale Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Stantelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes POZHIDAEV; Eugene Jablochkovast. home 21 block 2 apartment 43	onen vollständige amtliche es Staats anzugeben. Der itzes oder Wohnsitzes des angegeben ist.)	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)	
RUSSLAND Staatsangehörigkeit (Staat): Russian	Sitz oder Wohnsitz (Sta	RUSSIAN *	RO/EP
Diese Personist Anmelder alle Bestimmungsst für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten Sta	aaten mit Ausnahme aten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Perst Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name de in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des S Anmelders, sosern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes	onen vollständige amtliche es Staats anzugeben. Der itzes oder Wohnsitzes des angegeben ist.)	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)	
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (St	aat):	
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsst für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten Sta	taaten mit Ausnahme Laten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten	
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf eine	em zusätzlichen Fortsetz	ungsblatt angegeben.]

Blatt Nr. 3

	Nr. V				1
Die fol	genden gekreu	Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorger zt werden):	ommer	r (bitte d	die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen
	nales	Patent			
Ŏ	AP	ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE I SZ Swasiland, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder	weite	re Staa	csotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, t, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
	EA	Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikista Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT is	ın, TN st	1 Turk	clarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik menistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des
X	EP	DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finr IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, I der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinke	nland, l NL Ni omme	FR Fra ederlar ns und	und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, nkreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, nde, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, des PCT ist
	OA	CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der	nea-Bi Vertras	issau, esstaat	ikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart angeben)
Natio	nales	Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges !	erfahr	en gewü	inscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):
		Vereinigte Arabische Emirate			Liberia
Ħ		Albanien		LS	Lesotho
$\overline{\Box}$		Armenicn		LT	Litauen
ŏ		Österreich	$\overline{\Box}$	LU	Luxemburg
=		Australien	ŏ		Lettland
			ĭ		Republik Moldau
	-	Aserbaidschan			Madagaskar
		Bosnien-Herzegowina			
		Barbados		MIK	Die ehemalige jugoslawische Republik
		Bulgarien	_		Mazedonien
		Brasilien			Mongolei
	BY	Belarus			Malawi Malawi
	CA	Kanada		MX	Mexiko
	CH	und LI Schweiz und Liechtenstein		NO	Norwegen
	CN	China		NZ	Neusceland
		Kuba		PL	Polen
		Tschechische Republik		PT	Portugal
		Deutschland		RO	Rumänien
ă		Dänemark		RU	Russische Föderation
ă		Estland	$\overline{\Box}$	SD	Sudan
ä	ES	Spanien	$\overline{\Box}$	SE	Schweden
ă	FI	Finnland	$\overline{\Box}$	SG	Singapur
		Vereinigtes Königreich		SI	Slowenien
H		Grenada	ö		Slowakei
_		Georgien		SL	Sierra Leone
	GE	Georgien		TJ	Tadschikistan
		Ghana	H		Turkmenistan
		Gambia	=		Türkei
		Kroatien			Trinidad und Tobago
	HU	Ungarn		TT	
	ID	Indonesien			Ukraine
	IL	Israel			Uganda
	IN	Indien	X	US	Vereinigte Staaten von Amerika
	IS	Island			
X	JP	Japan			Usbckistan
	KE	Kenia		VN	Vietnam
	KG	Kirgisistan		YU	Jugoslawien
	KP	Demokratische Volksrepublik Korca			Südafrika
				zw	Simbabwe
	KR	Republik Korca	Käste	chen fi	or die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der
	ΚZ	Kasachstan	Verö	ffentli	chung dieses Formblatts beigetreten sind:
		Saint Lucia			
		Sri Lanka			
Rebl		had versoralisher Restimmungen: Zusätzlich 2	u den	oben	genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach
D	110.	About houch alle anderen nach dem PCT zulässige	n Kes	เเททเ	ingen vor mit Aushandie der int Zusatziele genannten i
Besti	mmur	igen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind.	DCI W	umero	die von Ablant von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum
aem nicht	v orde best#	tigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anm	elder	zurüc	kgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung gegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Frist von 15 Monaten eingehen.)
erfol	gt dur	ch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bes	timmu	ing an	gegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und
der B	estäti	gungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldean	*** ******	.,	der Frist von 15 Monaten eingenen.



Blatt Nr. .4....

- 2	
4	
1	ı

Feld Nr. VI PRIORITÄTS	ANSPRUCH		☐ Weitere	Prioritätsansprüche sind	l im Zusatzfeld angegeben	
Annieldedatum	Aktenzeichen	,		Ist die frühere Anmeldu	ng eine:	
der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	der früheren Anmelo	natio	nale Anmeldung: Staat	regionale Anmeldung:* regionales Amt	internationale Anmeldun Anmeldeamt	
Zeile (1) 30. August 1999 (30.08.1999)	19941079.8	DE				
Zeile (2)						
			,			
Zeile (3)						
Das Anmeldeamt wird ersuch bezeichneten früheren Anme dem Amt eingereicht worden	eldung(en) zu erstellen i n <i>ist(sind), das für die 2</i>	und dem inter Zw <i>ecke dieser</i>	nationalen Büro zu <i>internationalen Ant</i>	übermitteln (nur falls die meldung Anmeldeamt ist)		
* Falls es sich bei der früheren An. Mitgliedstaat der Pariser Verbandsi	meldung um eine ARIPO- ibereinkunft zum Schutz	-Anmeldung ha des gewerblic	ndelt, so muß in de hen Eigentums ist u	m Zusatzfeld mindestens ein und für den die frühere Ant	Staat angegeben werden, der meldung eingereicht wurde.	
	NALE RECHERCH					
Wahl der internationalen Recherch (falls zwei oder mehr als zwei inter behörden für die Ausführung der inte zuständig sind, geben Sie die von Ihne	mationale Recherchen- irnationalen Recherche n gewählte Behörde an;	frühere Rech	erche (falls eine früh r von ihr durchgefüh	ere Recherche bei der interna rt worden ist):	che; Bezugnahme auf diese ationalen Recherchenbehörde	
der Zweibuchstaben-Code kann benut: ISA / EP	tt werden):	Datum (10g.	/Monat/Jahr)	Aktenzeichen	Staat (oder regionales Ami)	
Feld Nr. VIII KONTROLLIS	STE; EINREICHUN	GSSPRAC	HE			
Diese internationale Anmeldung die folgende Anzahl von Blätte			nmeldung liegen o	die nachstehend angekrei	ızten Unterlagen bei:	
Antrag : 9			eichnete Vollmac	ht		
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) : 6				nt Aktenzeichen (falls vorh	anden): 38690	
Ansprüche : 3	4. 🔲 Begri	indung für d	as Fehlen einer Ur	nterschrift		
Zusammenfassung : 1	S KT Principate halon(a) in Fald No. 37 dough					
Zeichnungen : 2	Zeichnungen : 2 6. Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache:					
Sequenzprotokollteil der Beschreibung :— Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material						
8. Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen in computerlesbarer Form						
Blattzahl insgesamt : [19]	21 9. 🗷 Sonsti	ige (<i>einzeln d</i>	ufführen): Zusatz	zblatt 5-9		
Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.):	ļ	Sprache, in d internationale eingereicht w	Anmeldung do			
	T DES ANMELDER			•		
Der Name jeder unterzeichnenden aus dem Antrag ergibt, in welchei	Person ist neben der U Eigenschaft die Pers	Unterschrift zi son unterzeic	ı wiederholen, und hnet.	es ist anzugeben, sofern	sich dies nicht eindeutig	
Deutsche Telekom AG	MAG					
11///			•			
.A. ///////				.		
Dr. Frank Wedeland, Refere EPA-Vollmacht 38690	nt der Patentabte	ilung	Fortsetzung	Blatt 6-9		
	Von	n Anmeldess	nt auszufüllen —			
. Datum des tatsächlichen Einga internationalen Anmeldung:		4. 08. 00		2 4 AUG 2000	2. Zeichnungen einge-	
. Geändertes Eingangsdatum auf fristgerecht eingegangener Unt zur Vervollständigung dieser in	erlagen oder Zeichnu	ıngen	 		gangen:	
. Datum des fristgerechten Eingan Richtigstellungen nach Artikel	gs der angeforderten	·			nicht ein- gegangen:	
. Internationale Recherchenbehör (falls zwei oder mehr zuständig			6. DÜberm Zahlun	nittlung des Recherchener g der Recherchengebühr	xemplars bis zur aufgeschoben	
Datum des Eingangs des Aktene		ernationalen	Büro auszufüllen			

ROJEP ROJEP



Blatt Nr. .5



Zusatzseld Wird dieses Zusatzseld nicht benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.

- 1. Wenn der Platz in einem Feld nicht für alle Angaben ausreicht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr..." [Nummer des Feldes angeben] und machen die Angaben entsprechend der in dem Feld, in dem der Platz nicht ausreicht, vorgeschriebenen Art und Weise, insbesondere:
- (i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind und kein "Fortsetzungsblatt" zur Verfügung steht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. III" und machen für jede weitere Person die in Feld Nr. III vorgeschriebenen Angaben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.
- (ii) Wenn in Feld Nr. II oder III die Angabe "die im Zusatzfeld angegebenen Staaten" angekreuzt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" und geben den Namen des Anmelders oder die Namen der Anmelder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Anmelder ist.
- (iii) Wenn der in Feld Nr. II oder III genannte Erfinder oder Erfinder/Anmelder nicht für alle Bestimmungsstaaten oder für die Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinder benannt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. III und Nr. III" und geben den Namen des Erfinders oder die Namen der Erfinder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Erfinder ist.
- (iv) Wenn zusätzlich zu dem Anwalt oder den Anwälten, die in Feld Nr. IV angegeben sind, weitere Anwälte bestellt sind: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. IV" und machen für jeden weiteren Anwalt die entsprechenden, in Feld Nr. IV vorgeschriebenen Angaben.
- (v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikat," oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teilfortsetzung" hinzugefügt wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. V" und geben den Namen des betreffenden Staats (oder OAPI) an und nach dem Namen jedes solchen Staats (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsanmeldung.
- (vi) Wenn in Feld Nr. VI die Priorität von mehr als drei früheren Anmeldungen beansprucht wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und machen für jede weitere frühere Anmeldung die entsprechenden, in Feld Nr. VI vorgeschriebenen Angaben.
- (vii) Wenn in Feld Nr. VI die frühere Anmeldung eine ARIPO Anmeldung ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und geben, unter Angabe der Nummer der Zeile, in der die die frühere Anmeldung betreffenden Angaben gemacht sind, mindestens einen Staat an, der Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunst zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und für den die frühere Anmeldung erfolgte.
- 2. Wenn, im Hinblick auf die Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen in Feld Nr. V, der Anmelder Staaten von dieser Erklärung ausnehmen möchte: In diesem Fall schreiben Sie "Bestimmung(en), die von der Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen ausgenommen ist(sind)" und geben den Namen oder den Zweibuchstaben-Code jedes so ausgeschlossenen Staates an.
- 3. Wenn der Anmelder für irgendein Bestimmungsamt die Vorteile nationaler Vorschriften betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit in Anspruch nimmt: In diesem Fall schreiben Sie "Erklärung betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit" und geben im folgenden die entsprechende Erklärung ab.

Fortsetzung Feld I

Bezeichnung der Erfindung

VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM TEMPERATURUNABHÄNGIGEN BETRIEB VON ELEKTROOPTISCHEN SCHALTERN AUF DER GRUNDLAGE FERROELEKTRISCHER FLÜSSIGKRISTALLE MIT DEFOMIERTER HELIX



Blatt Nr. 6



Zusatzseld Wird dieses Zusatzseld nicht benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.

- 1. Wenn der Platz in einem Feld nicht für alle Angaben ausreicht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr...." [Nummer des Feldes angeben] und machen die Angaben entsprechend der in dem Feld, in dem der Platz nicht ausreicht, vorgeschriebenen Art und Weise, insbesondere:
 - (i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind und kein "Fortsetzungsblatt" zur Verfügung steht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. III" und machen für jede weitere Person die in Feld Nr. III vorgeschriebenen Angaben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.
- (ii) Wenn in Feld Nr. II oder III die Angabe "die im Zusatzfeld angegebenen Staaten" angekreuzt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" und geben den Namen des Anmelders oder die Namen der Anmelder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Anmelder ist.
- (iii) Wenn der in Feld Nr. II oder III genannte Erfinder oder Erfinder/Anmelder nicht für alle Bestimmungsstaaten oder für die Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinder benannt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. III" und geben den Namen des Erfinders oder die Namen der Erfinder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Erfinder ist.
- (iv) Wenn zusätzlich zu dem Anwalt oder den Anwälten, die in Feld Nr. IV angegeben sind, weitere Anwälte bestellt sind: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. IV" und machen für jeden weiteren Anwalt die entsprechenden, in Feld Nr. IV vorgeschriebenen Angaben.
- (v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikat," oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teilfortsetzung" hinzugefügt wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. V" und geben den Namen des betreffenden Staats (oder OAPI) an und nach dem Namen jedes solchen Staats (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsanmeldung.
- (vi) Wenn in Feld Nr. VI die Priorität von mehr als drei früheren Anmeldungen beansprucht wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und machen für jede weitere frühere Anmeldung die entsprechenden, in Feld Nr. VI vorgeschriebenen Angaben.
- (vii) Wenn in Feld Nr. VI die frühere Anmeldung eine ARIPO Anmeldung ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und geben, unter Angabe der Nummer der Zeile, in der die die frühere Anmeldung betreffenden Angaben gemacht sind, mindestens einen Staat an, der Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und für den die frühere Anmeldung erfolgte.
- 2. Wenn, im Hinblick auf die Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen in Feld Nr. V, der Anmelder Staaten von dieser Erklärung ausnehmen möchte: In diesem Fall schreiben Sie "Bestimmung(en), die von der Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen ausgenommen ist(sind)" und geben den Namen oder den Zweibuchstaben-Code jedes so ausgeschlossenen Staates an.
- 3. Wenn der Anmelder für irgendein Bestimmungsamt die Vorteile nationaler Vorschriften betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit in Anspruch nimmt: In diesem Fall schreiben Sie "Erklärung betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit" und geben im folgenden die entsprechende Erklärung ab.

Fortsetzung Feld IX

DULTZ; Wolfgang

DOLIE, Wongang





Zusatzfeld Wird dieses Zusatzfeld nicht benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.

- 1. Wenn der Platz in einem Feld nicht für alle Angaben ausreicht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr..." (Nummer des Feldes angeben) und machen die Angaben entsprechend der in dem Feld, in dem der Platz nicht ausreicht, vorgeschriebenen Art und Weise, insbesondere:
 - (i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind und kein "Fortsetzungsblatt" zur Verfügung steht: In diesem Fall schreiben Sie: "Fortsetzung von Feld Nr. III" und machen für jede weitere Person die in Feld Nr. III vorgeschriebenen Angaben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.
- (ii) Wenn in Feld Nr. II oder III die Angabe "die im Zusatzfeld angegebenen Staaten" angekreuzt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" und geben den Namen des Anmelders oder die Namen der Anmelder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Anmelder ist.
- (iii) Wenn der in Feld Nr. II oder III genannte Erfinder oder Erfinder/Anmelder nicht für alle Bestimmungsstaaten oder für die Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinder benannt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Erfinders oder die Namen der Erfinder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Erfinder ist.
- (iv) Wenn zusätzlich zu dem Anwalt oder den Anwälten, die in Feld Nr. IV angegeben sind, weitere Anwälte bestellt sind: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. IV" und machen für jeden weiteren Anwalt die entsprechenden, in Feld Nr. IV vorgeschriebenen Angaben.
- (v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikat," oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teilfortsetzung" hinzugefügt wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. V" und geben den Namen des betreffenden Staats (oder OAPI) an und nach dem Namen jedes solchen Staats (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsanmeldung.
- (vi) Wenn in Feld Nr. VI die Priorität von mehr als drei früheren Anmeldungen beansprucht wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und machen für jede weitere frühere Anmeldung die entsprechenden, in Feld Nr. VI vorgeschriebenen Angaben.
- (vii) Wenn in Feld Nr. VI die frühere Anmeldung eine ARIPO Anmeldung ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und geben, unter Angabe der Nummer der Zeile, in der die die frühere Anmeldung betreffenden Angaben gemacht sind, mindestens einen Staat an, der Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und für den die frühere Anmeldung erfolgte.
- 2. Wenn, im Hinblick auf die Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen in Feld Nr. V, der Anmelder Staaten von dieser Erklärung ausnehmen möchte: In diesem Fall schreiben Sie "Bestimmung(en), die von der Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen ausgenommen ist(sind)" und geben den Namen oder den Zweibuchstaben-Code jedes so ausgeschlossenen Staates an.
- 3. Wenn der Anmelder für irgendein Bestimmungsamt die Vorteile nationaler Vorschriften betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit in Anspruch nimmt: In diesem Fall schreiben Sie "Erklärung betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit" und geben im folgenden die entsprechende Erklärung ab.

Fortsetzung Feld IX

GANZKE; Dirk



Blatt Nr. .8....



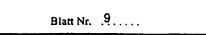
Zusatzfeld Wird dieses Zusatzfeld nicht benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.

- 1. Wenn der Platz in einem Feld nicht für alle Angaben ausreicht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. ..." [Nummer des Feldes angeben] und machen die Angaben entsprechend der in dem Feld, in dem der Platz nicht ausreicht, vorgeschriebenen Art und Weise, insbesondere:
- (i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind und kein "Fortsetzungsblatt" zur Verfügung steht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. III" und machen für jede weitere Person die in Feld Nr. III vorgeschriebenen Angaben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.
- (ii) Wenn in Feld Nr. II oder III die Angabe "die im Zusatzfeld angegebenen Staaten" angekreuzt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Anmelders oder die Namen der Anmelder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Anmelder ist.
- (iii) Wenn der in Feld Nr. II oder III genannte Erfinder oder Erfinder/Anmelder nicht für alle Bestimmungsstaaten oder für die Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinder benannt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. III" und geben den Namen des Erfinders oder die Namen der Erfinder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Erfinder ist.
- (iv) Wenn zusätzlich zu dem Anwalt oder den Anwälten, die in Feld Nr. IV angegeben sind, weitere Anwälte bestellt sind: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. IV" und machen für jeden weiteren Anwalt die entsprechenden, in Feld Nr. IV vorgeschriebenen Angaben.
- (v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikat," oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teilfortsetzung" hinzugefügt wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. V" und geben den Namen des betreffenden Staats (oder OAPI) an und nach dem Namen jedes solchen Staats (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsanmeldung.
- (vi) Wenn in Feld Nr. VI die Priorität von mehr als drei früheren Anmeldungen beansprucht wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und machen für jede weitere frühere Anmeldung die entsprechenden, in Feld Nr. VI vorgeschriebenen Angaben.
- (vii) Wenn in Feld Nr. VI die frühere Anmeldung eine ARIPO Anmeldung ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und geben, unter Angabe der Nummer der Zeile, in der die die frühere Anmeldung betreffenden Angaben gemacht sind, mindestens einen Staat an, der Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und für den die frühere Anmeldung erfolgte.
- 2. Wenn, im Hinblick auf die Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen in Feld Nr. V, der Anmelder Staaten von dieser Erklärung ausnehmen möchte: In diesem Fall schreiben Sie "Bestimmung(en), die von der Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen ausgenommen ist(sind)" und geben den Namen oder den Zweibuchstaben-Code jedes so ausgeschlossenen Staates an.
- 3. Wenn der Anmelder für irgendein Bestimmungsamt die Vorteile nationaler Vorschriften betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit in Anspruch nimmt: In diesem Fall schreiben Sie "Erklärung betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit" und geben im folgenden die entsprechende Erklärung ab.

Fortsetzung Feld IX

0 1 1

HAASE; Wolfgang



Zusatzseld Wird dieses Zusamseld nicht benumt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.

- 1. Wenn der Platz in einem Feld nicht für alle Angaben ausreicht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr..." [Nummer des Feldes angeben] und machen die Angaben entsprechend der in dem Feld, in dem der Platz nicht ausreicht, vorgeschriebenen Art und Weise, insbesondere:
- (i) Wenn mehr als zwei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind und kein "Fortsetzungsblatt" zur Verfügung steht: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. III" und machen für jede weitere Person die in Feld Nr. III vorgeschriebenen Angaben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.
- (ii) Wenn in Feld Nr. II oder III die Angabe "die im Zusatzfeld angegebenen Staaten" angekreuzt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. III" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Anmelders oder die Namen der Anmelder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Anmelder ist.
- (iii) Wenn der in Feld Nr. II oder III genannte Erfinder oder Erfinder/Anmelder nicht für alle Bestimmungsstaaten oder für die Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinder benannt ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. II", "Fortsetzung von Feld Nr. II" bzw. "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" und geben den Namen des Erfinders oder die Namen der Erfinder an und neben jedem Namen den Staat oder die Staaten (und/oder ggf. ARIPO-, eurasisches, europäisches oder OAPI-Patent), für die die bezeichnete Person Erfinder ist.
- (iv) Wenn zusätzlich zu dem Anwalt oder den Anwälten, die in Feld Nr. IV angegeben sind, weitere Anwälte bestellt sind: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. IV" und machen für jeden weiteren Anwalt die entsprechenden, in Feld Nr. IV vorgeschriebenen Angaben.
- (v) Wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei OAPI) die Angabe "Zusatzpatent" oder "Zusatzzertifikat," oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teilfortsetzung" hinzugefügt wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. V" und geben den Namen des betreffenden Staats (oder OAPI) an und nach dem Namen jedes solchen Staats (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsanmeldung.
- (vi) Wenn in Feld Nr. VI die Priorität von mehr als drei früheren Anmeldungen beansprucht wird: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und machen für jede weitere frühere Anmeldung die entsprechenden, in Feld Nr. VI vorgeschriebenen Angaben.
- (vii) Wenn in Feld Nr. VI die frühere Anmeldung eine ARIPO Anmeldung ist: In diesem Fall schreiben Sie "Fortsetzung von Feld Nr. VI" und geben, unter Angabe der Nummer der Zeile, in der die die frühere Anmeldung betreffenden Angaben gemacht sind, mindestens einen Staat an, der Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigennums ist und für den die frühere Anmeldung erfolgte.
- 2. Wenn, im Hinblick auf die Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen in Feld Nr. V. der Anmelder Staaten von dieser Erklärung ausnehmen möchte: In diesem Fall schreiben Sie "Bestimmung(en), die von der Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen ausgenommen ist(sind)" und geben den Namen oder den Zweibuchstaben-Code jedes so ausgeschlossenen Staates an.
- 3. Wenn der Anmelder für irgendein Bestimmungsamt die Vorteile nationaler Vorschriften betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit in Anspruch nimmt: In diesem Fall schreiben Sie "Erklärung betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit" und geben im folgenden die entsprechende Erklärung ab.

Fortsetzung Feld IX

Unterschrift wird nachgereicht.

POZHIDAEV; Eugene

至了成熟等 漢聲 雪空

年 (東京語)が大学



PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES F	Recherchenberichts (F	e Übermittlung des internationalen ormblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit				
P99129W0.1P		utreffend, nachstehen					
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelded (Tag/Monat/Jahr)		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)				
PCT/EP 00/08261	24/08/200)0	30/08/1999				
Anmelder DEUTSCHE TELEKOM AG et al.							
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In	ternationalen Büro übermitt		rstellt und wird dem Anmelder gemäß				
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jev		Blätter. em Bericht genannten	Unterlagen zum Stand der Technik bei.				
Grundlage des Berichts			•				
a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing	rnationale Recherche auf c gereicht wurde, sofern unte	ler Grundlage der inter r diesem Punkt nichts	rnationalen Anmeldung in der Sprache anderes angegeben ist.				
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	ie ist auf der Grundlage ein durchgeführt worden.	er bei der Behörde eir	ngereichten Übersetzung der internationalen				
b. Hinsichtlich der in der internationale Recherche auf der Grundlage des S	en Anmeldung offenbarten i Sequenzprotokolls durchge	Nucleotid- und/oder führt worden, das	Aminosāuresequenz ist die internationale				
in der internationalen Anme	•						
zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.							
bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.							
bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.							
Die Erklärung, daß das nac internationalen Anmeldung			oll nicht über den Offenbarungsgehalt der gt.				
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	omputerlesbarer Form erfaß	Bten Informationen der	n schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,				
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht recher	c hierbar erwiesen (si	ehe Feld I).				
3. MangeInde Einheitlichkei	t der Erfindung (siehe Feld	d II).					
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	•						
wird der vom Anmelder ein			•				
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgese	tzt:					
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung							
wird der vom Anmelder ein wurde der Wortlaut nach R Anmelder kann der Behörd Recherchenberichts eine S	egel 38.2b) in der in Feld III e innerhalb eines Monats n	angegebenen Fassur	ng von der Behörde festgesetzt. Der bsendung dieses internationalen				
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	ist mit der Zusammenfassu	ing zu veröffentlichen:	Abb. Nr1				
wie vom Anmelder vorgeso	hlagen		keine der Abb.				
X weil der Anmelder selbst ke	eine Abbildung vorgeschlag	en hat.					
weil diese Abbildung die Er	findung besser kennzeichn	et.					

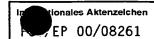
Feld III

WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1)

Ende vom Text on 50 kHz" inzu	wird "Die Be Igefügt.	etriebsfrec	quenz liegt	vorzusweise	oberhalb
					•

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT





a. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G02F1/141 G02F1/21

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 7 \ G02F$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, IBM-TDB, EPO-Internal, INSPEC, COMPENDEX

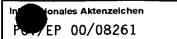
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	FUENFSCHILLING J ET AL: "PERFORMANCE OF CONVENTIONAL AND NOVEL DEFORMED HELIX FERROELECTRIC LIQUID CRYSTAL DISPLAY OPERATING MODES" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, JP, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. TOKYO, Bd. 35, Nr. 11, PART 01, 1. November 1996 (1996-11-01), Seiten 5765-5774, XP000618145 ISSN: 0021-4922 * Abschnitte 5 und 6 *	1-12
A	EP 0 356 730 A (HOFFMANN LA ROCHE) 7. März 1990 (1990-03-07) das ganze Dokument/	1,6,7,12

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	 'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist 'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden 'Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
13. Dezember 2000	22/12/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Stang, I

2

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT





		L.,,,
C.(Fortsetz Kategorie°	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	nenden Teile Betr. Anspruch Nr.
Kalegone	Dezeichnung der Veröhentlichung, Soweit entruenken unter Angabe der in Detracht könnt	enden Teile Den. Anspirati Ni.
Α	ABDULHALIM I ET AL: "ELECTRICALLY AND OPTICALLY CONTROLLED LIGHT MODULATION AND COLOR SWITCHING USING HELIX DISTORTION OF FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS" MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS (INC. NONLINEAR OPTICS), GB, GORDON AND BREACH SCIENCE PUBLISHERS, READING, Bd. 200, 1. Mai 1991 (1991-05-01), Seiten 79-101, XP000258405 * Abschnitte IV. und VI. * Abbildung 6	1-12
Α	DE 43 03 335 A (HOECHST AG; DISPLAYTECH INC (US)) 12. August 1993 (1993-08-12) Seite 3, Zeile 3 -Seite 5, Zeile 27 Seite 11, Zeile 66 -Seite 12, Zeile 13 Seite 12, Zeile 49 - Zeile 56; Abbildungen 2,4	1–12
T	POZHIDAEV E ET AL: "High frequency and high voltage mode of deformed helix ferroelectric liquid crystals in a broad temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG.—3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193 das ganze Dokument	1-12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

n on patent family members

In ional Application No
P 00/08261

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0356730 A	07-03-1990	DE 58908399 D HK 182996 A JP 2146525 A JP 2587109 B KR 192648 B	27-10-1994 11-10-1996 05-06-1990 05-03-1997 15-06-1999
DE 4303335 A	12-08-1993	US 5539555 A CA 2088934 A GB 2263982 A,B JP 6075224 A SE 9300375 A US 5753139 A	23-07-1996 08-08-1993 11-08-1993 18-03-1994 08-08-1993 19-05-1998

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 8. März 2001 (08.03.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/16647 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: 1/21

G02F 1/141,

PCT/EP00/08261

(21) Internationales Aktenzeichen:(22) Internationales Anmeldedatum:

24. August 2000 (24.08.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 41 079.8 30.

30. August 1999 (30.08.1999)

Deutsch

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): DEUTSCHE TELEKOM AG [DE/DE]; Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DULTZ, Wolfgang [DE/DE]; Marienberger Strasse 37, 65936 Frankfurt am Main (DE). GANZKE, Dirk [DE/DE]; Heidelbergerstr. 63, 64285 Darmstadt (DE). HAASE, Wolfgang [DE/DE]; Im Trappengrund 72, 64354 Reinheim (DE). POZHI-DAEV, Eugene [RU/RU]; Jablochkovast. Home 21, Block 2 Apartment 43, 127322 Moskau (RU).

(74) Gemeinsamer Vertreter: DEUTSCHE TELEKOM AG; Rechtsabteilung (Patente) PA1, 64307 Darmstadt (DE).

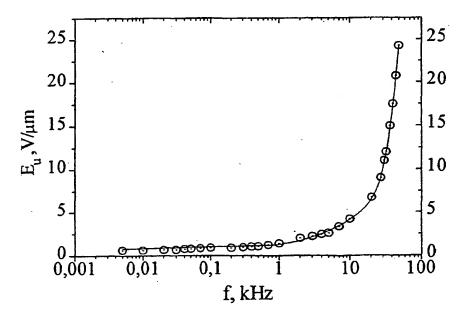
(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR CARRYING OUT A TEMPERATURE-INDEPENDENT OPERATION OF ELECTRO-OPTICAL SWITCHES BASED ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS HAVING A DEFORMED HELIX

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM TEMPERATURUNABHÄNGIGEN BETRIEB VON ELEKTROOPTISCHEN SCHALTERN AUF DER GRUNDLAGE FERROELEKTRISCHER FLÜSSIGKEITSKRISTALLE MIT DEFORMIERTER HELIX



(57) Abstract: The invention relates to a liquid crystal modulator comprising at least one ferroelectric liquid crystal, and to a method for operating an optical liquid crystal modulator having at least one ferroelectric liquid crystal. The aim of the invention is to greatly diminish temperature-dependent influences during simultaneously short switching times. To this end, the invention provides that the ferroelectric liquid crystals have a DHF mode and an operating range of the electric field that exceeds 10 V/µm at the location of the liquid crystal. The operating frequency is preferably greater than 50 kHz.

70 01/16647 A1

WO 01/16647 A1



Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der f\u00fcr \u00eAnderungen der Anspr\u00fcche geltenden Frist; Ver\u00f6ffentlichung wird wiederholt, falls \u00eAnderungen eintreffen.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Damit bei einem optischen Flüssigkristallmodulator mit zumindest einem ferroelektrischen Flüssigkristall und einem Verfahren zum Betrieb eines optischen Flüssigkristallmodulators mit zumindest einem ferroelektrischen Flüssigkristall, temperaturabhängige Einflüsse bei gleichzeitig kurzen Schaltzeiten stark vermindert sind, ist vorgesehen, dass die ferroelektrischen Flüssigkristalle eine DHF-Mode haben, und einen Betriebsbereich des elektrischen Feldes am Ort des Flüssigkristalls von mehr als 20 V/µm aufweisen. Die Betriebsfrequenz liegt vorzugsweise oberhalb von 50 kHz.

WO 01/16647 PCT/EP00/08261

Vorrichtung und Verfahren zum temperaturunabhängigen Betrieb von elektrooptischen Schaltern auf der Grundlage ferroelektrischer Flüssigkeitskristalle mit deformierter Helix

5

10

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 6 zum temperaturunabhängigen Betrieb von elektrooptischen Schaltern auf der Grundlage ferroelektrischer Flüssigkeitskristalle mit deformierter Helix.

Optische Flüssigkeitskristalle haben seit fast 20 Jahren die 15 Displaytechnik grundlegend verändert. Als preiswerte und sparsame Lichtventile dienen sie aber insbesondere auch zur Schaltung optischer Nachrichtenflüsse. Durch die Entwicklung der ferroelektrischen Flüssigkristalle sind die Schaltzeiten in den Bereich von Mikrosekunden gerückt worden. 20 Schwierigkeiten macht aber nach wie vor die hohe Temperaturabhängigkeit der meisten physikalischen Parameter eines Flüssigkristalls. In vielen technischen Geräten müssen die Bauelemente in einem weiten Temperaturbereich, die gleichen Eigenschaften aufweisen. Besonders im Fahrzeugbau 25 werden dabei Temperaturen von -30° C bis +80° C als Vorgaben genannt. Auch optische Überlastungsschalter von Videoüberwachungssystemen im Freien können diesen Temperaturen ausgesetzt sein.

30

35

Beispiele für weitere Anwendungen sind doppelbrechende Interferenzfilter, die mit Hilfe von Flüssigkristallen spektral abgestimmt werden (C. BARTA, et al., Kristalloptisches Interferenzfilter Europäisches Patent 0 907 089 A2).

Auch sog. optisch oder elektrisch adressierbare ortsauflösende Flüssigkristallmodulatoren (OASLM, EASLM), die zur Umwandlung von inkohärenter Bildinformation in kohärente Bildinformation dienen, können bisher nur in engen Temperaturbereichen betrieben werde, da sich deren Schaltzeiten mit der Temperatur sehr stark ändern.

Der Erfindung liegt folglich die Aufgabe zu Grunde; die vorstehend beschriebenen Nachteile zu mildern und insbesondere eine Vorrichtung und ein Verfahren bereitzustellen, bei welchem temperaturabhängige Einflüsse bei gleichzeitig hohen Schaltzeiten stark vermindert sind.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit dem Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 6 gelöst.

Gemäß der Erfindung wird eine Vorrichtung und ein Verfahren bereitgestellt, bei welchem ferroelektrische Flüssigkristalle eine im weitem Bereich temperaturunabhängige und sehr geringe Schaltzeit haben und somit besonders vorteilhaft für optische Schalter im Freien und in Fahrzeugen eingesetzt werden können.

25

30

20

Gemäß der Erfindung wird vorteilhaft ein optischer Flüsigkristallmodulator verwendet, bei welchem die ferroelektrischen Flüssigkristalle eine DHF-Mode haben und werden bevorzugt in einem Bereich des elektrischen Feldes von mehr als $20V/\mu m$ betrieben. Dadurch besitzt der Modulator in einem Frequenzbereich, der im wesentlichen oberhalb von $50~\rm kHZ$ liegt, eine temperaturunabhängige und äußerst niedrige Ansprechzeit.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter
Ausführungsbeispiele und unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen detaillierter beschrieben.
Es zeigen:

5

Figur 1: Die Abhängigkeit des elektrischen Feldes E_c , das zur vollständigen Aufwindung der Helix nötig ist, von der Schaltfrequenz f bei $T=20.0^{\circ}C$ wobei die Messung an einer 2,0 μ m dicken Zelle an der flüssigkristallinen Mischung FLC-388 durchgeführt wurde und die Helixganghöhe Po bei einer Temperatur $T=20.0^{\circ}C$ den Wert von 0,22 μ m hatte,

10

Figur 2: Die Abhängigkeit der Schaltzeit τ des effektiven Tiltwinkels $\theta_{\rm eff}$ und des Kontrastverhältnisses CR von der Frequenz des elektrischen Feldes. Schichtdicke d=1,8 μ m, 20 $V_{\rm pp}$, T=35°C,

15

20

Figur 3: Die Temperaturabhängigkeit der Schaltzeit $\tau_{0,1-0,9}$ im DHF Mode bei einer Frequenz f = 130kHz und E = ± 15 V/ μ m (Kurve 1) und beim Schalten des vollständig entwundenen Zustandes (E > E_u) bei f=10 kHz und E= ± 15 V/ μ m (Kurve 2), die Temperaturabhängigkeit des Tiltwinkels θ im DHF Mode bei f = 130 kHz und E = ± 15 V/ μ m (Meßkurve 3) und im entwundenen Zustand bei f = 10 kHz und E = ± 15 V/ μ m (Kurve 4).

25

30

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

Die Erfindung verwendet ferroelektrische Flüssigkristalle zur Modulation von Licht in Flüssigkristallmodulatoren, deren Aufbau, insbesondere deren äußere, insbesondere aus transparentem Material bestehende Elektroden und deren Zellen dem Fachmann auf diesem Gebiet wohlbekannt sind, weshalb eine detailliertere Beschreibung des mechanischen und elektrischen Aufbaus sich erübrigt.

Es werden ferroelektrische Flüssigkristalle verwendet, deren Helix eine geringe Ganghöhe (< 300 µm) aufweist und sich mit einem geringen elektrischen Feld kontinuierlich deformiert läßt (sog. DHF-Mode). Dieser DHF Mode ermöglicht eine kontinuierliche Variation des effektiven Tiltwinkels θ_{eff} und der effektiven Doppelbrechung $\Delta\eta_{eff}$ bei geringen Spannungen (< 5V) und geringen Schaltzeiten (< lms). Die Größe des effektiven Tiltwinkels ist gleich des halben Drehungwinkels der Indikatrix des Flüssigkristalls im elektrischen Feld; das heißt, je größer der effektive Tiltwinkel ist, um so stärker dreht sich die Indikatrix des Flüssigkristalls.

Da optische Flüssigkristallmodulatoren auf der Basis der DHF-Mode als Lambda/2 Vergrößerungsplatten ausgebildet werden, die sich im elektrischen Feld drehen, sind bei einmaligem Durchgang durch die Platte Tiltwinkel von ± 22.5 Grad notwendig, um eine vollständige Auslöschung von polarisiertem Licht im Schaltzustand "AUS" und vollständige Transparenz im Schaltzustand "EIN" zu erhalten.

20

25

30

35

10

15

Das elektrische Feld E_{0} , das durch vollständige Aufwindung der Helix erforderlich ist und dabei den gewünschten Tiltwinkel hervorrüft, ist bei kleinen Frequenzen relativ klein (Figur 1, $E_{0} \sim 0.5$ bis 1 V/ μ m bei Frequenzen f kleiner 1 kHz). Mit höheren Frequenzen nimmt diese Grenzfeldstärke zu; außerdem sinkt auch der Tiltwinkel, siehe Figuren 1 und 2.

Bei Frequenzen über 50 kHz sind Felder $E_{\text{U}}>20$ V/µm zur vollständigen Entwindung der Helix notwendig. Die Region in der sich der DHF-Effekt ausnutzen läßt wird somit zu höheren Feldern hin verschoben.

Da höhere Felder wegen der höheren Spannungen am Flüssigkristall nachteilig sind und außerdem zu kleineren

10

25

Tiltwinkeln führen, wurde dieser Bereich bisher nicht als technisch interessant angesehen.

Figur 1 zeigt die Abhängigkeit des elektrischen Feldes E_c , das zur vollständigen Aufwindung der Helix nötig ist, von der Schaltfrequenz f bei $T=20.0^{\circ}C$. Die Messung wurde an einer 2,0 μ m dicken Zelle an einer selbsthergestellten flüssigkristallinen Mischung FLC-388 durchgeführt. Die Helixganghöhe Po beträgt = 0,22 μ m bei einer Temperatur von $T=20.0^{\circ}C$.

Ferner kann die Helixganghöhe Po bei einer Temperatur von ungefähr $T = 20.0^{\circ}$ C, d.h. bei etwa Raumptemperatur in einem Bereich von 0,1 bis 0,5 liegen.

Mit höheren Frequenzen wird die Ansprechzeit τ aber um über mehr als eine Größenordnungen gesenkt, während der Tiltwinkel θ bis zu sehr hohen Frequenzen nahezu konstant bleibt (Figur 2). Mit der Schaltzeit sinkt damit zwar auch das Kontrastverhältnis und die Doppelbrechung, aber es werden immer noch für Anwendungen akzeptable Werte erreicht.

Figur 2 zeigt die Abhängigkeit der Schaltzeit τ des effektiven Tiltwinkels $\theta_{\rm eff}$ und des Kontrastverhältnisses CR von der Frequenz des elektrischen Feldes bei einer Schichtdicke d = 1,8 μm und 20 V_{pp} sowie einer Temperatur von T = 35°C.

Figur 3 zeigt als Beispiel eine Messung der Ansprechzeit τ in Abhängigkeit von der Temperatur für ein solches

- Flüssigkristallsystem. Während die Ansprechzeit τ für einen Betrieb des Flüssigkristalls bei 10 kHz stark temperaturabhängig ist (Kurve 2), ist sie bei einer Betriebsfrequenz von 130 kHz nicht nur sehr klein, sondern auch absolut temperaturkonstant (Kurve 1). Der effektive
- 35 Tiltwinkel ändert sich dabei nur wenig und auch die

Temperaturabhängigkeit (Kurve 3 + 4) ist erst über 50° C nicht mehr zu vernachlässigen.

Durch eine weitergehende Optimierung der Mischungen ließe sich gemäß der Erfindung erwartungsgemäß ein schneller Flüssigkeitskristallschalter für einen Anwendungsbereich von -20 bis 80° C entwickeln.

Patentansprüche

- Optischer Flüssigkristallmodulator mit zumindest einem ferroelektrischen Flüssigkristall, dadurch gekennzeichnet,
 - daß die ferroelektrischen Flüssigkristalle eine DHF-Mode haben, und einen Betriebsbereich des elektrischen Feldes am Ort des Flüssigkristalls von mehr als 20 V/ μ m aufweisen.
- Optischer Flüssigkristallmodulator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Flüssigkristallmodulator mit der DHF-Mode als Lambda/2 Vergrößerungsplatten ausgebildet ist, welche sich im elektrischen Feld drehen und bei einmaligem Durchgang durch die Platte Tiltwinkel von ± 22.5 Grad erzeugt werden.
- Optischer Flüssigkristallmodulator nach Anspruch 1 oder
 2, dadurch gekennzeichnet,
 daß der Flüssigkristallmodulator eine flüssigkristalline
 Mischung FLC-388 umfaßt.
- 4. Optischer Flüssigkristallmodulator nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Helixganghöhe Po bei einer Temperatur von ungefähr T = 20.0° C in einem Bereich von 0,1 bis 0,5 liegt.
- 5. Optischer Flüssigkristallmodulator nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Helixganghöhe Po bei einer Temperatur von ungefähr T = 20.0° C bei etwa 0,22 µm liegt.

10

15

20

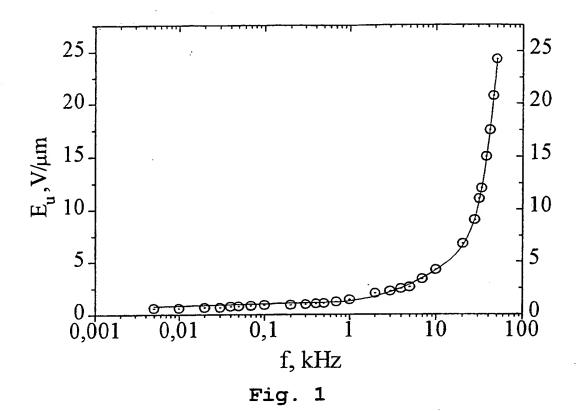
25

30

35

- 6. Optischer Flüssigkristallmodulator nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ansteuerungsfrequenz der Ansteuerungsspannung des Flüssigkristallmodulators wenigstens 10 kHz beträgt und bevorzugt oberhalb von 50 kHz liegt.
- 7. Verfahren zum Betrieb eines optischen Flüssigkristallmodulators, welcher einen ferrolektrischen Flüssigkristall umfaßt, und insbesondere eines Flüssigkristallmodulators nach einem der Ansprüche von 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die ferroelektrischen Flüssigkristalle eine DHF-Mode haben, und in einen Betriebsbereich des elektrischen Feldes am Ort des Flüssigkristalls von mehr als 20 V/μm betrieben werden.
 - 8. Verfahren zum Betrieb eines optischen Flüssigkristallmodulators nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Flüssigkristallmodulator mit der DHF-Mode als Lambda/2 Vergrößerungsplatten verwendet wird, welche sich im elektrischen Feld drehen und bei einmaligem Durchgang durch die Platte Tiltwinkel von ± 22.5 Grad erzeugt werden.
 - 9. Verfahren zum Betrieb eines optischen Flüssigkristallmodulators nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß für den ferroelektrischen Flüssigkristall eine flüssigkristalline Mischung FLC-388 verwendet wird.
- 10. Verfahren zum Betrieb eines optischen
 Flüssigkristallmodulators nach Anspruch 7, 8 oder 9,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß ein Flüssigkristall verwendet wird, bei welchem die
 Helixganghöhe Po bei einer Temperatur von ungefähr
 T = 20.0°C in einem Bereich von 0,1 bis 0,5 liegt.

- 11. Verfahren zum Betrieb eines optischen Flüssigkristallmodulators nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß ein ferroelektrischer Flüssigkristall verwendet wird, bei welchem die Helixganghöhe Po bei einer Temperatur von ungefähr T = 20.0° C bei etwa 0,22 μm liegt.
- 12. Verfahren zum Betrieb eines optischen
 Flüssigkristallmodulators nach einem der vorstehenden
 Ansprüche von 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
 daß die Ansteuerungsfrequenz der Ansteuerungsspannung
 des Flüssigkristallmodulators wenigstens 10 kHz beträgt
 und bevorzugt oberhalb von 50 kHz liegt.



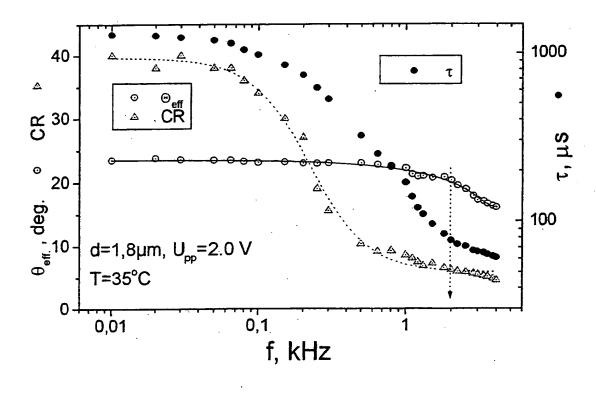
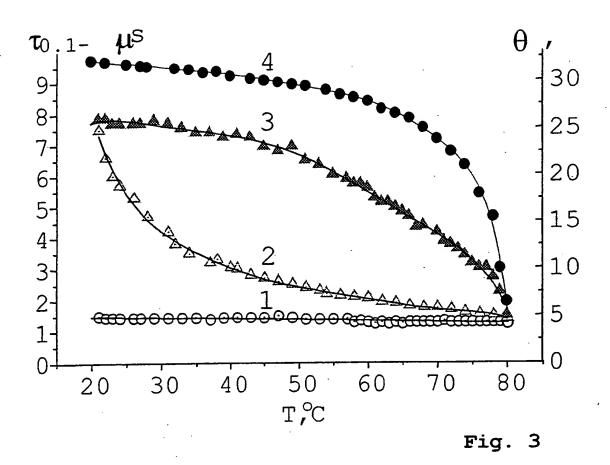


Fig. 2



INTERNATION SEARCH REPORT

PCT/EP_00/08261

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G02F1/141 G02F1/21

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G02F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, PAJ, IBM-TDB, EPO-Internal, INSPEC, COMPENDEX

	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the resevant passages	
A	FUENFSCHILLING J ET AL: "PERFORMANCE OF CONVENTIONAL AND NOVEL DEFORMED HELIX FERROELECTRIC LIQUID CRYSTAL DISPLAY OPERATING MODES" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, JP, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. TOKYO, vol. 35, no. 11, PART 01, 1 November 1996 (1996-11-01), pages 5765-5774, XP000618145 ISSN: 0021-4922 * Paragraphs 5 and 6 *	1-12
A	EP 0 356 730 A (HOFFMANN LA ROCHE) 7 March 1990 (1990-03-07) the whole document	1,6,7,12

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E' earlier document but published on or after the international filing date L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	 "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
13 December 2000	22/12/2000
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fay: (-31-70) 340-3016	Stang, I

Fax: (+31-70) 340-3016

INTER TIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP 00/08261

	<u> </u>	PCT/EP 00	/08261 .	
C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.	
A .	ABDULHALIM I ET AL: "ELECTRICALLY AND OPTICALLY CONTROLLED LIGHT MODULATION AND COLOR SWITCHING USING HELIX DISTORTION OF FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS" MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS (INC. NONLINEAR OPTICS), GB, GORDON AND BREACH SCIENCE PUBLISHERS, READING, vol. 200, 1 May 1991 (1991-05-01), pages 79-101, XP000258405 ** Paragraphs IV and VI * figure 6		1-12	:
4	DE 43 03 335 A (HOECHST AG; DISPLAYTECH INC (US)) 12 August 1993 (1993-08-12) page 3, line 3 -page 5, line 27 page 11, line 66 -page 12, line 13 page 12, line 49 - line 56; figures 2,4		1-12	
T	POZHIDAEV E ET AL: "High frequency and high voltage mode of deformed helix ferroelectric liquid crystals in a broad temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, vol. 246, no. 1-4, pages 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193 the whole document		1-12	
		•		
			•	
		,		
		-		
		•		
	·			

NTERNATIO: 🗘 SEARCH I

hadrmation on patent family members

Interna Application No PCT/EP 00/08261

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0356730	Α	07-03-1990	DE	58908399 D	27-10-1994
			HK	182996 A	11-10-1996
			JP	2146525 A	05-06-1990
			JP	2587109 B	05-03-1997
		•	KR	192648 B	15-06-1999
DE 4303335	Α	12-08-1993	US	5539555 A	23-07-1996
			CA	2088934 A	08-08-1993
			GB	2263982 A,B	11-08-1993
			JP	6075224 A	18-03-1994
•			SE	9300375 A	08-08-1993
			US	5753139 A	19-05-1998

INTERNATIONALER R AERCHENBERICHT

Internar des Aktenzeicher PCT/EP 00/08261

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G02F1/141 G02F1/21

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G02F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, IBM-TDB, EPO-Internal, INSPEC, COMPENDEX

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	FUENFSCHILLING J ET AL: "PERFORMANCE OF CONVENTIONAL AND NOVEL DEFORMED HELIX FERROELECTRIC LIQUID CRYSTAL DISPLAY OPERATING MODES" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, JP, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. TOKYO, Bd. 35, Nr. 11, PART 01, 1. November 1996 (1996-11-01), Seiten 5765-5774, XP000618145 ISSN: 0021-4922 * Abschnitte 5 und 6 *	1-12
A	EP 0 356 730 A (HOFFMANN LA ROCHE) 7. Mārz 1990 (1990-03-07) das ganze Dokument/	1,6,7,12

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden solf oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden: ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kalegorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamitie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 13. Dezember 2000	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 22/12/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter

Stang, I

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

(Fortsetz alegorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
	· ·	
	ABDULHALIM I ET AL: "ELECTRICALLY AND OPTICALLY CONTROLLED LIGHT MODULATION AND COLOR SWITCHING USING HELIX DISTORTION OF FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS" MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS	1-12
	(INC. NONLINEAR OPTICS), GB, GORDON AND BREACH SCIENCE PUBLISHERS, READING, Bd. 200, 1. Mai 1991 (1991-05-01), Seiten 79-101, XP000258405 * Abschnitte IV. und VI. * Abbildung 6	
	DE 43 03 335 A (HOECHST AG ;DISPLAYTECH INC (US)) 12. August 1993 (1993-08-12) Seite 3, Zeile 3 -Seite 5, Zeile 27 Seite 11, Zeile 66 -Seite 12, Zeile 13 Seite 12, Zeile 49 - Zeile 56; Abbildungen 2,4	1–12
	POZHIDAEV E ET AL: "High frequency and high voltage mode of deformed helix ferroelectric liquid crystals in a broad	1-12
	temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193 das ganze Dokument	
	temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193	
	temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193	
	temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193	
	temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193	
	temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193	
	temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193	
	temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193	
	temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193	
	temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193	
	temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193	
	temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193	
	temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193	
	temperature range" SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS, DARMSTADT, GERMANY, 29 AUG3 SEPT. 1999, Bd. 246, Nr. 1-4, Seiten 1141-1151, XP000974877 Ferroelectrics, 2000, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 0015-0193	

INTERNATIONALER REL

RCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internat & Aktenzeichen

PCT/EP 00/08261

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0356730 A	07-03-1990	DE 58908399 D HK 182996 A JP 2146525 A JP 2587109 B KR 192648 B	27-10-1994 11-10-1996 05-06-1990 05-03-1997 15-06-1999
DE 4303335 A	12-08-1993	US 5539555 A CA 2088934 A GB 2263982 A,B JP 6075224 A SE 9300375 A US 5753139 A	23-07-1996 08-08-1993 11-08-1993 18-03-1994 08-08-1993 19-05-1998